

Поз. обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
VD1		Диод Шоттки MBR130LSFT1G; 1A; 30B;	1	
		ф. ON Semiconductor, США; корпус SOD-123.		
		Индуктивность		
L1		Индуктивность LQG15HS27NJ02D;	1	
		ф. Murata, Япония; 27 нГн; 5%; корпус 0402.		
		Фильтр		
L2		Фильтр BLM18RK121SN1D;1200hm at 100MHz;	1	
		200mA; корпус 0603; ф. Murata, Япония.		
		Кнопочные переключатели		
SA1		Переключатель KLS7-SS-12F19-G5; ф. KLS,	1	
		Китай.		
SB1-SB4		Кнопка тактовая KLS7-TS6604-4.3-180;	4	
		ф. KLS, Китай.		
		Конденсаторы электролитические		
C1		TECAP, 0.1 мкФ, 35В, тип А, 10%, Китай.	1	
C2		TECAP, 10 мкФ, 35В, тип А, 10%, Китай.	1	
		Конденсаторы керамические		
C3		GRM319R71H104K; ф. Murata, Япония;	1	
		0,1 мкФ; 50 В; 10%; X7R; корпус 1206.		
C4		GRM31MR71H105K; ф. Murata, Япония;	1	
		1 мкФ; 50 В; 10%; X7R; корпус 1206.		
C5,C6		GRM3165C1H220JD01D; ф. Murata, Япония;	2	
		22 пФ; 50 В; 10%; X7R; корпус 1206.		
				</

Поз. обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
C 7		GRM31BR72J103K; ф. Mugaта, Япония; 0,01 мкФ; 50 В; 10%; X7R; корпус 1206.	1	
C 8–C 10		GRM319R71H104K; ф. Mugaта, Япония; 0,1 мкФ; 50 В; 10%; X7R; корпус 1206.	3	
C 11		GRM31CR71E106KA12L; ф. Mugaта, Япония; 10 мкФ; 50 В; 10%; X7R; корпус 1206.	1	
C 12–C 16		GRM319R71H104K; ф. Mugaта, Япония; 0,1 мкФ; 50 В; 10%; X7R; корпус 1206.	5	
ZQ1		Кварцевый резонатор HC-49SM-24 МГц; Китай.	1	
		Микросхемы		
DA1		MIC5201-3.3YS-0.2A; корпус SOT-223; ф. Microchip Technology, США.	1	
DD1		Микросхема NEO-6М; ф. U-Blox, Швейцария	1	
DD2		Микросхема STM32F100C8T6B; Швейцария, ф. ST Microelectronics; корпус LQFP-48.	1	
		Разъемы		
XS1		Клеммник KLS2-125-3.81-02P; ф. KLS, Китай.	1	
XS2		Разъем U. FL-R-SMT-1; ф. Hirose Electric, Япония.	1	
XS3		Гнездо на плату 2,54мм 1x4 прямое PBS-4; ф. Ningbo connfly electronic, Китай.	1	
XS4		Гнездо на плату 2,54мм 1x8 прямое PBS-8; ф. Ningbo connfly electronic, Китай.	1	
		Резисторы		
R1, R2		RC1206JR-072K4L; 0,25 Вт; 24 кОм; ±1%; корпус 1206; Тайвань.	2	

[illegible]